

Patent number: EP0732635

Publication date: 1996-09-18

Inventor: HAENNI WALTER (CH); PERRET ANDRE (CH)

Applicant: SUISSE ELECTRONIQUE MICROTECH (CH)

Classification:

- international: G04D3/00; B23P15/00

- european: G04D3/00D10; H01H1/00M

Application number: EP19960103115 19960301

Priority number(s): FR19950003642 19950317

Also published as:

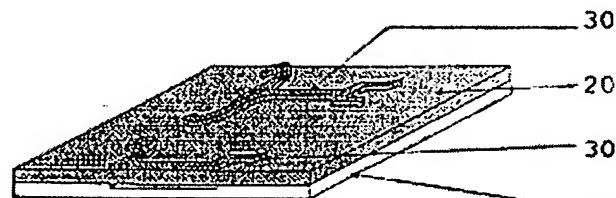
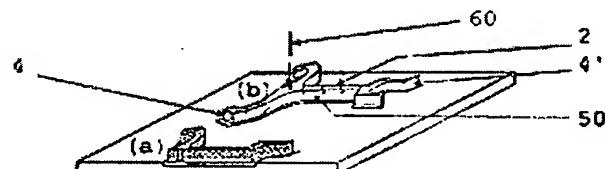
- FR2731715 (A1)
 EP0732635 (B1)

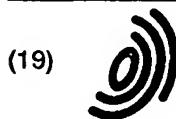
Cited documents:

- US5242711
 EP0596455
 EP0605300
 WO9305401
 EP0413040

[Report a data error here](#)**Abstract of EP0732635**

A micro-mechanical component is cut out from a base plate (20) made of a first crystalline material by anisotropic attack. This process takes effect in the direction of the thickness of the plate using a gas excited by plasma, surrounding a mask (30) of the required shape mounted above the plate. This first material may be either mono-crystalline or polycrystalline silicon or its oxide or its nitride. The parts of the component which are intended to come into contact with another component are re-coated by chemical deposition from the vapour phase with a second material. The second material is chosen to offer suitable coefficients of hardness and wear resistance for their task. The second material may, for example, be crystalline carbon in the form of diamond.

**Fig. 3****Fig. 5**



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 732 635 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
18.09.1996 Bulletin 1996/38(51) Int. Cl.⁶: G04D 3/00, B23P 15/00

(21) Numéro de dépôt: 96103115.0

(22) Date de dépôt: 01.03.1996

(84) Etats contractants désignés:
CH DE FR GB LI

(30) Priorité: 17.03.1995 FR 9503642

(71) Demandeur: C.S.E.M. CENTRE SUISSE
D'ELECTRONIQUE ET DE MICROMECHANIQUE
SA
CH-2007 Neuchâtel (CH)

(72) Inventeurs:

- Hänni, Walter
2034 Peseux (CH)
- Perret, André
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (CH)

(74) Mandataire: Kiehl, Hubert
MOINAS, KIEHL, SAVOYE & CRONIN,
42, rue Plantamour
1201 Genève (CH)

(54) Pièce de micro-mécanique et procédé de réalisation

(57) Une pièce de micro-mécanique (2) est découpée dans une plaque de base (20) en un premier matériau cristallin par attaque anisotropique dans le sens de l'épaisseur au moyen d'un gaz excité par plasma, et ce autour d'un masque de forme (30) ménagé préalablement sur la face de la plaque. Ce premier matériau peut être du silicium monocristallin ou polycristallin, ou son oxyde ou son nitrure. Les parties (4) de la pièce suscep-

tibles d'entrer en contact avec une autre pièce sont revêtues par la suite par dépôt chimique en phase vapeur d'une couche (50) d'un second matériau de dureté et de coefficient de frottement prédéterminés. Ce second matériau est de préférence du carbone cristallisé sous forme de diamant, dont la surface peut être, si désiré, oxygénée, hydrogénée ou fluorée.

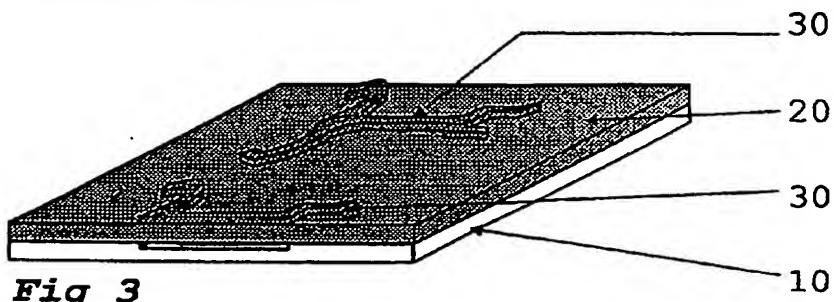


Fig. 3

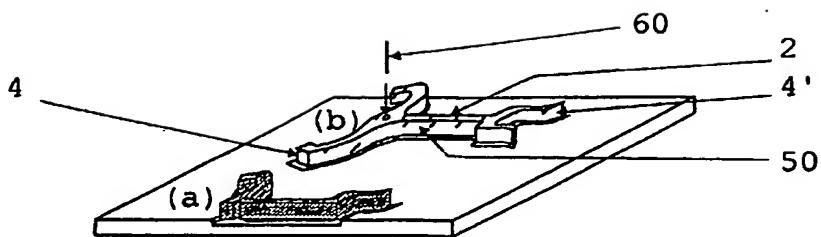


Fig. 5

BEST AVAILABLE COPY

EP 0 732 635 A1

- phique d'une couche d'un matériau résistant à une attaque plasma,
- découper sur tout le pourtour de chaque masque et dans toute l'épaisseur de la plaque du premier matériau par gravure anisotropique verticale au moyen d'un gaz excité par plasma, chaque pièce n'étant plus retenue à la plaque de support que par un ou plusieurs ponts de matière,
 - éliminer le premier masque de forme,
 - si désiré, réaliser un second masque de forme ne recouvrant que certaines parties de chaque pièce,
 - déposer par dépôt chimique en phase vapeur une couche d'un second matériau de dureté et de coefficient de frottement prédéterminés,
 - si désiré, réaliser une métallisation des parois d'orifices transversaux et
 - détacher mécaniquement chaque pièce de la plaque de support.

Utillement, l'épaisseur initiale de la plaque du premier matériau cristallin est amincie à une valeur pré-déterminée par attaque chimique avant réalisation du premier masque de forme. Utillement encore, on réalise le dépôt d'une ou plusieurs couches de matériau intermédiaire avant le dépôt du second matériau externe de dureté et de coefficient de frottement prédéterminés.

On connaît, certes, des pièces de silicium réalisées en lots sur un substrat par dépôt de couche de matière puis gravure sélective à l'aide de masque selon les techniques appliquées à la réalisation de circuits intégrés. Par exemple, le document FR 2 697 536 décrit la réalisation d'un activateur de table X/Y suspendue dont certaines poutres sont profilées en U avec ou sans ailettes latérales complémentaires. Un autre exemple peut être trouvé dans le document FR 2 697 675 décrivant le procédé de réalisation d'un transducteur capacitif intégré pour microphone. La communication "Micromechanical Polysilicon Shutters and Mirrors for Light Modulator Arrays" faite à la conférence "Eurosensors, Budapest, 26-29 Septembre 1993" décrit la réalisation d'un réseau de miroirs rotatifs, chacun suspendu de chaque côté à une poutre de torsion, ainsi que la réalisation d'un réseau d'obturateurs pour rayon laser, chaque plaque obturateur étant tenue à l'extrémité d'un ressort flexible selon un seul axe horizontal.

Toutefois, à la lecture de ces documents, on se rend compte que ces réalisations ne concernent que des pièces microscopiques, c'est-à-dire d'épaisseur de l'ordre de 1 à 10 μ . Surtout, ces pièces sont systématiquement mises en mouvement par des forces agissant à distance : forces électrostatiques ou électromagnétiques, variation de pression ; et nullement par contact avec une autre pièce. Il est par ailleurs notoirement connu que le silicium est cassant, par exemple en flamboage ou en cisaillement, selon certaines orientations de leur plan cristallin. Il n'est donc pas envisageable de pouvoir tailler entièrement une pièce mécanique à partir d'un bloc de silicium avec les méthodes courantes de la micro-mécanique, à savoir perçage, fraisage, limage, et

ce librement dans n'importe quel plan. De plus, il est également connu que le silicium s'érode au contact avec d'autres pièces et qu'il possède un coefficient de frottement très important. Chacun de ces facteurs ne pouvait que décourager le mécanicien d'utiliser un tel matériau pour réaliser une pièce afin de l'inclure dans un mécanisme.

Or, dans l'esprit de l'invention, on a d'abord constaté que la majorité des pièces de micro-mécanique rotatives : roue dentée, pignon, ressort spiral, ancre, levier, ont en fait une forme principale contenue dans un plan, lequel plan n'est traversé que par un ou deux axes orthogonaux. De plus, on a constaté que les efforts d'interaction entre les pièces sont plutôt du type "de compression" dès lors que les parties concernées sont suffisamment dimensionnées

Par ailleurs, après de nombreuses études en atelier, on parvient, certes avec de nombreuses difficultés, à rendre l'attaque d'un gaz excité par plasma suffisamment anisotropique pour envisager la découpe pratiquement à la verticale par gravure continue sur une épaisseur d'au moins 1/10ème de millimètre, voire de 4/10ème de millimètre, d'une plaque en matériau cristallin, épaisseur correspondant alors au minimum d'une pièce usuelle de micro-mécanique.

L'invention consiste d'abord à réaliser des pièces en matériau cristallin en des dimensions permettant leur assemblage dans les mécanismes de micro-mécanique usuels tels que mouvement d'horlogerie. L'invention consiste ensuite à rendre ces pièces mécaniquement utilisables en effectuant un recouvrement des parties actives, telles que les dents d'un pignon ou d'une ancre, avec un second matériau dur empêchant premièrement une érosion prématuree de ces parties, mais permettant surtout de modifier très sensiblement le coefficient de frottement. L'invention consiste également à métalliser des orifices borgnes ou traversant dans lesquels sont installés des axes de rotation et de support.

Bien que relativement onéreuse à réaliser, l'utilisation de ces matériaux cristallins s'avère intéressante pour des pièces cruciales d'un mécanisme, par exemple un ressort spiral et son balancier dans un mouvement horloger. En effet, l'usinage s'effectue en des dimensions extrêmement précises. Plus légères, ces pièces présentent des inerties moindres, une insensibilité à la température et aux champs magnétiques naturels.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre d'un mode de réalisation, dont les étapes sont illustrées sous les figures 1 à 5 annexées, et ce pour une ancre de mouvement horloger, étant bien entendu que cette pièce est prise à titre d'exemple nullement limitatif, ce procédé pouvant s'appliquer avec peu de modifications pour d'autres pièces horlogères telles que le ressort-spiral ou le balancier, ou pour toute autre pièce de micro-mécanique essentiellement plane pouvant entrer dans un mécanisme.

seur de silicium supérieure à 100 µ est la technique de gravure ionique réactive.

La machine de gravure ionique réactive telle que prévue comprend notamment une enceinte à vide, deux générateurs radio-fréquence RF et un porte-sous-trait cryogénique assurant des températures de travail de -175°C à +20°C. L'enceinte à vide est pourvue d'un sas de chargement/déchargement divisé en deux sections. La zone supérieure, plus petite, est utilisée pour la génération du plasma. La zone inférieure, à travers laquelle diffusent les espèces actives confinées magnétiquement (type ECR), contient le substrat à graver. Le flux des espèces actives vers la plaque est contrôlé en variant l'intensité d'un champ magnétique induit par une bobine installée à l'extérieur entre les deux sections de l'enceinte. Le premier générateur RF est responsable de la création du plasma, et l'autre polarise le porte-sous-trait. La machine est pourvue d'une électronique de commande, d'un groupe de pompage avec pompe turbomoléculaire et des lignes de gaz idoines. Une vanne asservie permet en outre d'ajuster la pression indépendamment des débits de gaz.

La plaque de silicium devant être gravée est chargée via le sas et installée sur le porte-sous-trait cryogénique dans l'enceinte mise ensuite sous vide. Les gaz réactifs sont introduits aux débits voulus dans la partie supérieure de l'enceinte. Après un délai permettant de stabiliser la pression à sa valeur de travail, le premier générateur RF amorce alors le plasma. Des quantités d'espèces chimiquement actives sont ainsi générées et diffusent en direction du substrat à graver. L'énergie des ions incidents est contrôlée au moyen du second générateur RF qui polarise le porte-sous-trait. Le processus de gravure démarre alors. Les produits de réaction volatiles sont évacués par la ligne de pompage. Lorsque la profondeur est atteinte, les générateurs RF et l'introduction des gaz s'arrêtent, et l'enceinte est vidée. La plaque gravée est alors déchargée et remise à l'air ambiant via le sas.

Les produits chimiques utilisés sont à base fluorée ($O_2 + SF_6$). La pression de travail se situe entre 1 et 2 Pa. La température du porte-sous-trait est ajustée à -100°C. La puissance délivrée par le premier générateur RF de création du plasma est de 1500W. La puissance du second générateur dépend de l'intensité que l'on souhaite donner à l'effet RIE. Le temps de gravure est fonction de la profondeur à graver.

Les cavités 12 formées préalablement dans le substrat 10 ayant un pourtour plus large que celui de l'ancre 2 finalement formée, l'érosion ultime du matériau de base 20 libère la pièce 2 du substrat 10 hormis quelques ponts de matière 3 aisément cassables lorsque désiré. Le résidu d'oxyde du masque 30 apparaissant à la surface supérieure est ensuite éliminé, par attaque chimique et la pièce est nettoyée par voie chimique tel qu'illustré sur la figure 5a.

Une pièce brute de micro-mécanique ainsi obtenue présente déjà, au sein d'un mécanisme, l'avantage d'un

faible poids, donc d'une inertie très réduite, et de très faibles coefficients thermique et magnétique.

Par contre, le fait qu'un lot de pièces soit, à ce stade, toujours présent sur un même substrat permet 5 d'envisager, immédiatement à la suite, un ou plusieurs traitements complémentaires simultanément sur toutes ces pièces.

Selon l'invention, un traitement complémentaire consiste à former ou à déposer un revêtement 50 en un 10 second matériau de dureté et de coefficient de frottement prédéterminés, soit de manière générale sur toute la surface de la pièce, soit de manière sélective au moyen de masque sur seulement les parties de la pièce devant interagir avec d'autres pièces, par exemple sur 15 les dents 4 et la fourche 4' de l'ancre 2.

Notamment, pour une pièce et sa contre-pièce, on peut d'abord définir un couple de matériau de revêtement optimisant les critères de tribologie, puis on détermine, selon la nature du matériau de base et/ou la 20 forme de chaque pièce, le mode de dépôt ou de formation du revêtement le plus approprié. Parmi les premiers couples possibles de matériau de revêtement, on peut citer le nitre de titane contre carbure de titane ou carbure de silicium.

En fait, selon l'invention, on a découvert que le 25 matériau le plus remarquable pour cette application est le carbone déposé chimiquement en phase vapeur sous la forme de diamant, et de préférence sous forme polycristalline pour éviter tout risque de clivage.

Un tel dépôt de carbone cristallisé sous la forme régulière du diamant est en fait possible dès lors que le gaz d'apport, tel qu'un méthane comportant du carbone, est atomisé sous très forte chaleur (et non pas seulement cassé sous forme moléculaire), et que ce carbone atomisé rencontre une surface de condensation plus froide dont la micro-structure est compatible avec sa forme cristalline. Un tel apport de chaleur peut être réalisé soit au sein d'un filament thermique, ou au milieu d'une flamme de combustion dûment réglée, soit 30 par une torche plasma entretenue par micro-ondes ou par émission radio à très haute fréquence, soit par un plasma à micro-ondes ou à micro-ondes magnéto-actives.

Les couples de matériaux de revêtement préférés 35 selon l'invention sont ainsi le diamant contre diamant présentant un coefficient de friction bien inférieur à 0,1 ; ou diamant contre diamant dont la couche externe est complétée de fluor, d'oxygène ou d'hydrogène ; voire diamant contre carbone amorphe, ce dernier matériau 40 étant obtenu avec une température de dépôt plus basse. Dans la pratique, on a constaté que des épaisseurs de revêtement comprises entre 0,1 et 3 µ sont suffisantes pour obtenir l'effet recherché.

Dans le cas particulier de l'ancre 2 illustrée sur la 45 figure 5, la technique de dépôt de diamant la plus appropriée, est soit la méthode par filament thermique, soit une méthode au plasma à micro-ondes.

Dans la méthode par filament thermique (TF-CVD pour Thermal-Filament-Chemical-Vapor-Deposition),

- surface peut être, si désiré, oxygénée, hydrogénée ou fluorée.
5. Pièce selon la revendication 1, caractérisée en ce que le second matériau de revêtement (50) est du carbone amorphe ou du carbure ou nitre de titane, ou du carbure ou nitre de silicium, ou du nitre de bore hexagonal ou cubique. 5
6. Pièce selon la revendication 1, caractérisée en ce que les bords supérieur, inférieur et la paroi interne d'un orifice (9) sont métallisés par déposition chimique en phase vapeur. 10
7. Procédé de réalisation d'une pièce (2) selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il consiste à : 15
- fixer une plaque (20) d'un premier matériau cristallin à plat sur une plaque de support (10), laquelle plaque de support a préalablement été excavée ou ajourée (12) selon une forme pré-déterminée par structuration lithographique, 20
 - réaliser sur la face supérieure de la plaque du premier matériau (20) un premier masque de forme (30) correspondant au pourtour d'une pluralité de pièces désirées, et ce par dépôt puis structuration lithographique d'une couche d'un matériau résistant à une attaque plasma, 25
 - découper sur tout le pourtour de chaque masque (30) et dans toute l'épaisseur de la plaque (20) du premier matériau par gravure anisotropique verticale au moyen d'un gaz excité par plasma, chaque pièce (2) n'étant plus retenue à la plaque de support que par un ou plusieurs ponts de matière (3). 30
 - éliminer le premier masque de forme (30), 35
 - si désiré, réaliser par structuration lithographique un second masque de forme (40) ne recouvrant que certaines parties de chaque pièce (2), 40
 - déposer par dépôt chimique en phase vapeur une couche (50) d'un second matériau de dureté et de coefficient de frottement prédéterminés, et 45
 - détacher mécaniquement chaque pièce (2) de la plaque de support (10).
8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'épaisseur initiale de la plaque du premier matériau cristallin est amincie à une valeur prédéterminée par attaque chimique avant réalisation du premier masque de forme. 50
9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'on réalise le dépôt d'une ou plusieurs couches de matériau intermédiaire avant le dépôt du second matériau externe de dureté et de coefficient de frottement prédéterminés. 55
10. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'on réalise, en outre, une métallisation des parois d'orifices transversaux.



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 96 10 3115

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	
A	US-A-5 242 711 (DE NATALE ET AL.) 7 Septembre 1993 * colonne 8, ligne 35 - colonne 9, ligne 64; figures 6A-6L *	1,2,4,7, 9	G04D3/00 B23P15/00
A,D	EP-A-0 596 455 (CSEM CENTRE SUISSE D ELECTRONIQUE ET DE MICROMECHANIQUE) 11 Mai 1994 * colonne 5, ligne 28 - colonne 7, ligne 33; figures 6-14 *	1,7	
A	EP-A-0 605 300 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 6 Juillet 1994 * colonne 12, ligne 20 - colonne 14, ligne 12 *	1,7	
A	WO-A-93 05401 (THE CHARLES STARK DRAPER LAB) 18 Mars 1993 * page 27, ligne 16 - page 30, ligne 7 *	1,7	
A	EP-A-0 413 040 (IBM) 20 Février 1991 * revendications 1-7 *	1,7	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
	-----		G01P C23C G04D H02K H02N H01H
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche	Date d'achèvement de la recherche	Examinateur	
LA HAYE	25 Juin 1996	Patterson, A	
CATEGORY DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul	T : théorie ou principe à la base de l'invention		
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie	E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date		
A : arrière-plan technologique	D : cité dans la demande		
O : divulgation non-écrite	L : cité pour d'autres raisons		
P : document intercalaire	& : membre de la même famille, document correspondant		